

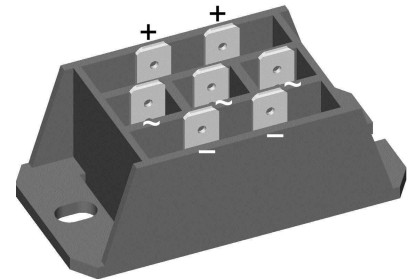
Standard Rectifier Module

3~ Rectifier	
V_{RRM}	= 1200 V
I_{DAV}	= 60 A
I_{FSM}	= 500 A

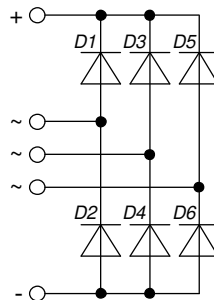
3~ Rectifier Bridge

Part number

VUO50-12NO3



 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: FO-F

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- 1/4" fast-on terminals
- Easy to mount with two screws
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

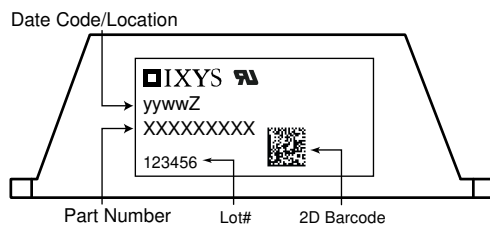
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1300	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					1200	V
I_R	reverse current	$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	μA
		$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.07	V
		$I_F = 60$ A				1.32	V
		$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.98	V
		$I_F = 60$ A				1.30	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 110^\circ\text{C}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		60	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
V_{FO}	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.78	V
r_F	slope resistance					8.5	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.4		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		80	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		500	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		540	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		425	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		460	A
I^2t	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.25	kA ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.22	kA ² s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		905	A ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		880	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		25	pF



Package FO-F		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				45		g
M_D	mounting torque		2		2.5	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	18.0	6.0		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	26.0	20.0		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA		3600	V
		t = 1 minute			3000	V

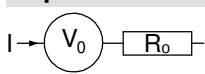


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO50-12NO3	VUO50-12NO3	Box	10	417246

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

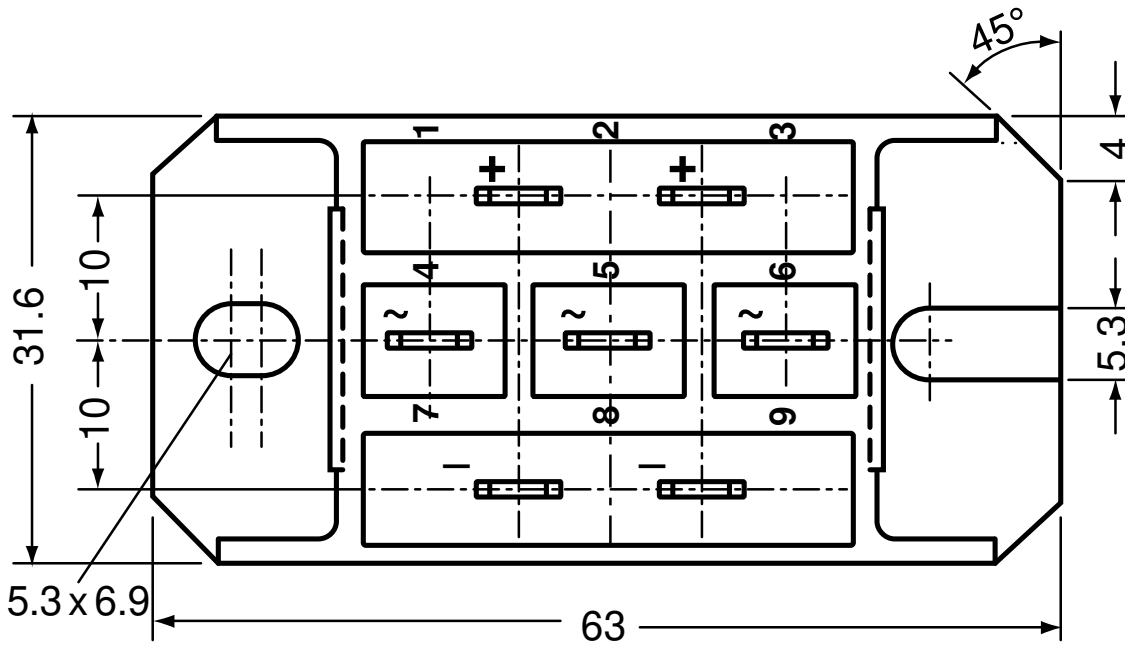
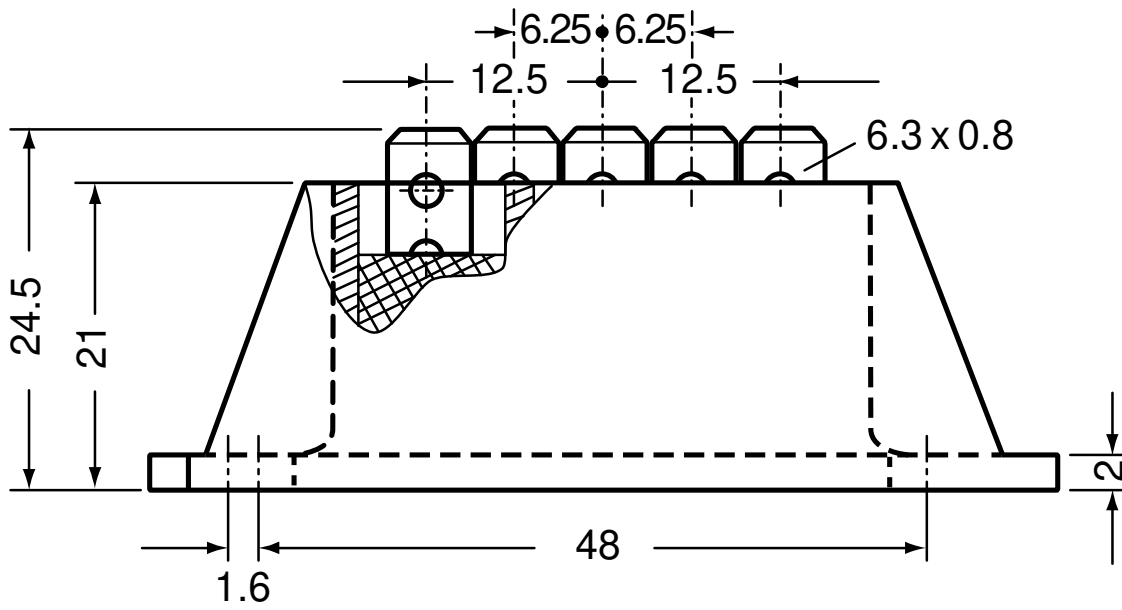


Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.78	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	7.3	mΩ



Outlines FO-F





Rectifier

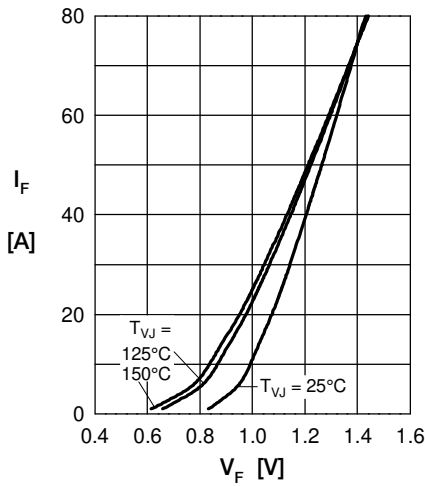


Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode

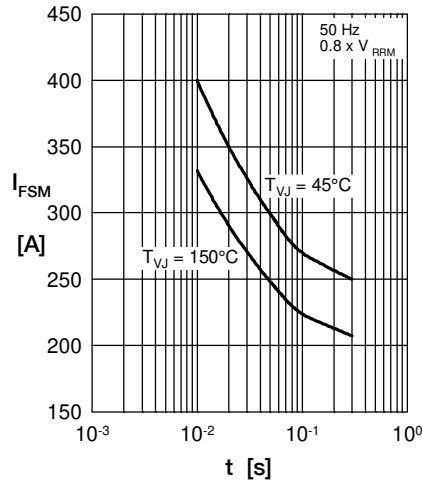


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

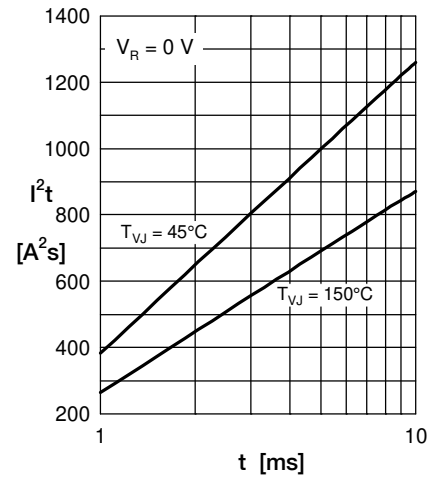


Fig. 3 I^2t vs. time per diode

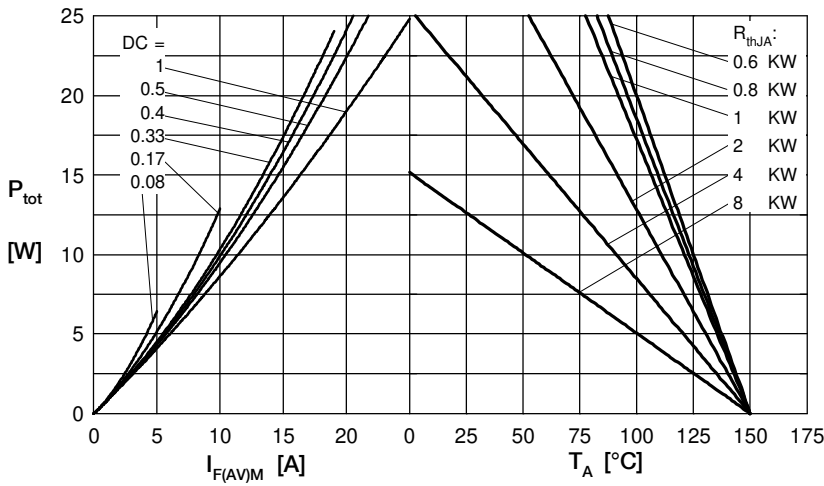


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

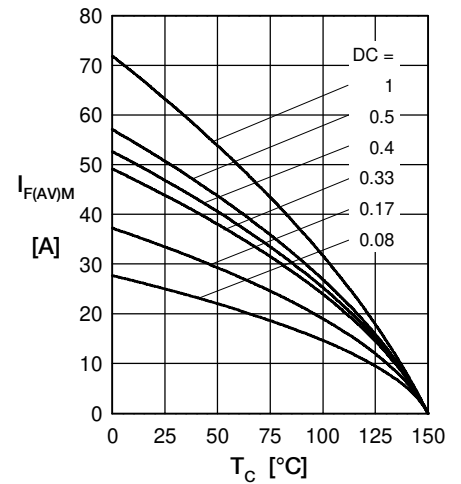


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

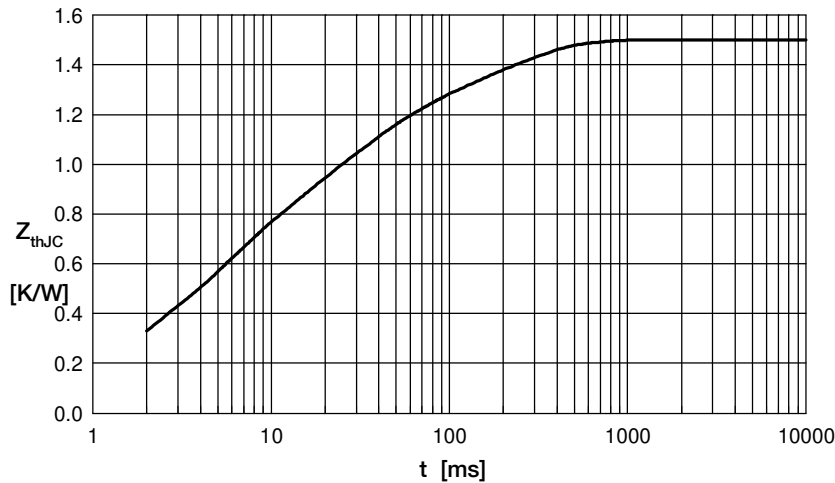


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{th} (K/W)	t_i (s)
1	0.0607	0.00040
2	0.1330	0.00256
3	0.4305	0.00450
4	0.5130	0.02420
5	0.3628	0.18000

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru